

Concise Explanation of documents

Excerpted English translation of JP-A-11-222641

From line 1 in column 1 to line 6 in column 2 on page (2)
[Claims]

[Claim 1] A copper alloy for conductive springs, containing, as main components, 1.0 to 3.5 wt% of Ni, 0.2 to 0.9 wt% of Si, 0.01 to 0.20 wt% of Mg, and 0.05 to 1.5 wt% of Sn, with S and O in a content restricted to less than 0.005 wt% respectively, with the balance being Cu and inevitable impurities, and having a crystal grain size of more than 1 μm and 25 μm or less.

[Claim 2] A copper alloy for conductive springs, containing, as main components, 1.0 to 3.5 wt% of Ni, 0.2 to 0.9 wt% of Si, 0.01 to 0.20 wt% of Mg, 0.05 to 1.5 wt% of Sn and 0.2 to 1.5 wt% of Zn, with S and O in a content restricted to less than 0.005 wt% respectively, with the balance being Cu and inevitable impurities, and having a crystal grain size of more than 1 μm and 25 μm or less.

[Claim 3] The copper alloy for conductive springs according to claim 1 or 2, wherein the copper alloy further contains 0.005 to 2.0 wt% in total of one or more elements selected from 0.005 to 0.3 wt% of Ag, 0.01 to 0.5 wt% of Mn, 0.005 to 0.2 wt% of Fe and Cr respectively, 0.05 to 2.0 wt% of Co, and 0.005 to 0.1 wt% of P.

[Claim 4] The copper alloy for conductive springs according to claim 1 or 2, wherein the copper alloy further contains 0.005 to 0.13 wt% in total of one or two elements selected from 0.005 to 0.1 wt% of Pb and 0.005 to 0.03 wt% of Bi.

[Claim 5] The copper alloy for conductive springs according to claim 1 or 2, wherein the copper alloy further contains 0.005 to 2.0 wt% in total of one or more elements selected from 0.005 to 0.3 wt% of Ag, 0.01 to 0.5 wt% of Mn, 0.005 to 0.2 wt% of Fe and Cr respectively, 0.05 to 2.0 wt% of Co, and 0.005 to 0.1 wt% of P and one or two components selected 0.005 to 0.1 wt% of Pb and 0.005 to 0.03 wt% of Bi.

[Claim 6] The copper alloy for conductive springs according to any one of claims 1 to 5, wherein the alloy is used for any of terminals, connector materials, and switch materials.

[Claim 7] A manufacturing method of the copper alloy for conductive springs according to any one of claims 1 to 6, wherein recrystallization treatment is carried out at 700 to 920°C after cold working.

[Claim 8] A manufacturing method of the copper alloy for conductive springs according to any one of claims 1 to 6, wherein recrystallization treatment is carried out at 700 to 920°C after cold working, and then aging treatment is

carried out at 420 to 550°C.

[Claim 9] A manufacturing method of the copper alloy for conductive springs according to any one of claims 1 to 6, wherein recrystallization treatment is carried out at 700 to 920°C after cold working, cold working with a reduction of 25% or less is further carried out, and then aging treatment is carried out at 420 to 550°C.

[Claim 10] A manufacturing method of the copper alloy for conductive springs according to any one of claims 1 to 6, wherein recrystallization treatment is carried out at 700 to 920°C after cold working, cold working with a reduction of 25% or less and then aging treatment at 420 to 550°C are carried out, and further cold-working with a reduction of 25% or less and low-temperature annealing are carried out.

From line 21 to 25 in column 10 on page (6)

[0031]

[Best Mode for Carrying out the Invention]

A copper alloy of the present invention has excellent mechanical strength, bending property, stress relaxation property, resistance to Sn-plating peeling, and punching suitability, and especially has properties required for a common conductive material such as terminal-connector materials, switch materials, relay materials, and the like; and the alloy will be described

in detail referring to examples.

From line 12 to 17 in column 12 on page (7) and Table 1
[0039]

The thermal peeling resistance of the Sn plating was evaluated in the following manner. A test piece of each of the sample sheets was subjected to a glossy tin plating with a thickness of 1 μm , and the resultant test piece was heated at 150°C for 1,000 hours in atmospheric air, followed by 180-degree contact bending and bending back. After that, the peeling of the plating at the bent portion was observed with the naked eye. In the case solder peeling was observed, a word, existing, was written in Tables 4 to 6.

[Table 1]

This invention	No.	Ni	Si	Mg	Sn	Zn	S	O	Others	Grain size
	1	1.5	0.34	0.07	0.31	0.49	0.002	0.001		5
	2	1.9	0.48	0.08	0.30	0.48	0.002	0.001		↑
	3	2.5	0.60	0.08	0.30	0.49	0.002	0.001		↑
	4	3.0	0.75	0.07	0.31	0.50	0.002	0.001		↑
	5	2.0	0.48	0.04	0.30	0.50	0.002	0.001		↑
	6	1.9	0.48	0.03	0.85	0.49	0.002	0.001		↑
	7	2.0	0.47	0.08	0.87	0.50	0.002	0.001		↑
	8	2.0	0.46	0.16	0.29	0.09	0.002	0.001		↑
	9	2.0	0.47	0.16	0.30	1.10	0.002	0.001		↑
	10	2.0	0.48	0.08	0.30	1.07	0.002	0.001		↑
	11	1.9	0.46	0.04	0.87	0.10	0.002	0.001		↑
	12	2.0	0.48	0.07	0.85	1.10	0.002	0.001		↑
	13	1.5	0.47	0.08	0.33	0.50	0.002	0.001	Co 0.5	↑
	14	1.9	0.48	0.08	0.31	0.49	0.002	0.001	Co 0.1	↑
	15	2.0	0.48	0.08	0.32	0.49	0.002	0.001	Ag 0.03	↑
	16	2.0	0.48	0.07	0.32	0.49	0.002	0.001	Pb 0.03	↑
	17	2.0	0.47	0.08	0.33	0.50	0.002	0.001	Cr 0.007	↑
	18	1.9	0.48	0.07	0.32	0.48	0.002	0.001		2
	19	2.0	0.48	0.06	0.33	0.49	0.002	0.001		10
	20	2.0	0.46	0.08	0.33	0.50	0.002	0.001		15
	21	1.9	0.48	0.08	0.31	0.50	0.002	0.001		20

Concise explanation with respect to JP-A-11-222641

If heat/electric conductivity of an alloy is poor, stress relaxation is accelerated due to heating of the alloy itself. Accordingly, the balance between conductivity and stress relaxation property is necessarily considered. JP-A-11-222641 describes a copper alloy developed by the present inventors and others, which alloy satisfy the balance between conductivity and stress relaxation property. However, with respect to the alloy in JP-A-11-22641, there is room for further improvement in compatibility to plating and in resistance to deterioration of plate after plating (which are collectively called as plating characteristics).

Excerpted English translation of JP-A-11-256256

From line 1 in column 1 to line 3 in column 2 on page (2)

[Claims]

[Claim 1] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability, comprising 0.1-4.0 wt% of Ni, 0.01-1.0 wt% of Si, 0.01-5.0 wt% of Zn, 0.005 or less wt% of S, and 0.005 or less wt% in total of one or more elements selected from the following group consisting of 0.003 wt% or less of Se, 0.003 wt% or less of Te, 0.003 wt% or less of Sb, and 0.003 wt% or less of Bi, with the balance being Cu and inevitable impurities.

[Claim 2] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability, comprising 0.1-4.0 wt% of Ni, 0.01-1.0 wt% of Si, 0.01-5.0 wt% of Zn, 0.0001-0.005 wt% of S, and 0.00003-0.005 wt% in total of one or more elements selected from the group consisting of 0.00003-0.003 wt% of Se, 0.00003-0.003 wt% of Te, 0.00003-0.003 wt% of Sb, and 0.00003-0.003 wt% of Bi, with the balance being Cu and inevitable impurities.

[Claim 3] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability according to claim 1 or 2, further containing 0.0001-0.05 wt% in total of one or two elements selected from the group consisting of 0.0001-0.05 wt% of Pb and 0.0001-0.01 wt% of C.

[Claim 4] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability according to any one of claims 1 to 3, further containing 0.0001-0.3 wt% in total of one or two elements selected from the group consisting of 0.0001-0.1 wt% of P and 0.0005-0.3 wt% of Al.

[Claim 5] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability according to any one of claims 1 to 4, further containing 0.001-1.5 wt% of Mg.

[Claim 6] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability according to any one of claims 1 to 5, further containing 0.0003-0.7 wt% in total of one or more elements selected from the group consisting

of 0.001-0.5 wt% of Mn, 0.001 wt% or more but less than 0.03 wt% of Fe, 0.001-0.1 wt% of Co, 0.0003-0.1 wt% of Ag, 0.0005-0.01 wt% of Cr, 0.0005-0.01 wt% of Zr, and 0.0005-0.01 wt% of Ti.

[Claim 7] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability according to any one of claims 1 to 6, further containing oxygen in a content of 30 ppm or less and hydrogen in a content of 10 ppm or less.

[Claim 8] A copper alloy for electric and electronic parts excellent in stamping workability according to any one of claims 1 to 7, further containing 0.01-8.0 wt% of Sn.

From line 37 in column 8 on page (5) to line 8 in column 9 on page (6)

[0025] A lead frame, for which the alloy of the present invention finds utility, is heated at 200 to 350°C in the step of mounting-packaging an Si chip. In the step of wire bonding, in order to prevent oxidation at the time of heating, usually the heating is performed in a non-oxidative atmosphere such as a nitrogen-hydrogen mixed gas. However, because of difficulty of completely preventing the penetration of air into the heating furnace, or because of prolongation of its residence time in the furnace, for example, in case of the occurrence of stopping of the line due to unexpected matter, the lead frame undergoes oxidation by the penetrating air. If the

adhesion strength between the oxide film produced on the surface of the lead frame and the matrix is low, after resin molding, moisture will penetrate through a gap formed when the oxide film is peeled off from the matrix so that the reliability of the IC is considerably decreased. For this reason, when the alloy is used for a lead frame, adhesion of its oxide film is one of important prescribed properties. With respect to surface roughness of the alloy of the present invention, if the center line average roughness (Ra) exceeds $0.2\ \mu\text{m}$ or the maximum height (Rmax) exceeds $1.0\ \mu\text{m}$, the adhesion of the oxide film is decreased. In consideration of this, it is desirable that with respect to the surface roughness, Ra is $0.2\ \mu\text{m}$ or less and Rmax is $1.0\ \mu\text{m}$ or less. Then, when the surface roughness satisfies these conditions, no problem occurs in plating suitability, bending workability, and the like, so that the alloy is suitable for electric and electronic parts such as a lead frame, a terminal and a connector.

From line 45 in column 24 on page (13) to line 5 in column 26 on page (14)

[0058] <Test Method> Influences of surface roughness on the adhesion of oxide film were examined by the following methods.

[Surface Roughness] Each test piece subjected to

ultrasonic cleaning with acetone was measured of its roughness by scanning a probe parallel to the direction of rolling over a length of 5 mm. Five test pieces for each sample exhibited approximately the same surface roughness. As the surface roughness of each sample, an average value of data on the five test pieces was used. For the measurement of surface roughness, a stylus type surface roughness measuring apparatus (produced by Taylor Hobson) was used. Note that the definition of surface roughness was according to JIS-B0601 (Definition of and indication of surface roughness).

[0059] [Adhesion of Oxide Film] On a hot plate (HOT PLATE HHP-401, produced by SEFI Co.) kept at 300°C were placed test pieces of respective surface roughness values and heated for 30 minutes. After predetermined period of time, the test pieces were cooled to room temperature, then a commercially available acetate adhesive tape (3M No. 810) was applied thereto and immediately peeled off therefrom. Presence or absence of attachment of the oxide film onto the adhesive surface of the tape was examined by visual observation. No attachment of oxide film to the adhesive surface was evaluated as O, and any attachment of oxide film thereto was evaluated as X. Note that the heating test with the hot plate, and peeling off test were performed in a chamber at 25°C and at relative humidity of

60%.

[0060] [Test Results] Results obtained are shown in Table 10.

[0061]

[Table 10]

Table 10: Relationship between Surface Roughness and Peeling of Oxide Film

No.	Ra μm	Rmax μm	Peeling of oxide film
27-7	0.06	0.35	○
27-8	0.12	0.74	○
27-9	0.25*	1.16	×
27-10	0.44*	2.8	×

[0062] In No. 27-7 and No. 27-8 having Ra of 0.2 μm or less and Rmax of 1.0 μm or less with respect to a surface roughness, the oxide film did not peel off, while in No. 27-9 and No. 27-10 whose surface roughness exceeded the above-mentioned range, the oxide film peeled off.

Excerpted English translation of JP-A-5-59468

From lines 1 to 25 in column 1 on page (2)

[Claims]

[Claim 1] A copper alloy for conductive springs,
comprising 0.5-4.0 % (means wt%, hereinafter the same) of

Ni, 0.1-1.0 % of Si, 0.01 to 0.1 % of Mg, 0.0015 % or less of S, 0.0015 % or less of O, and the balance of Cu.

[Claim 2] A copper alloy for conductive springs, comprising 0.5 to 4.0% of Ni, 0.1 to 1.0% of Si, 0.01 to 0.1% of Mg, 0.01 to 15% of Zn, 0.0015% or less of S, 0.0015% or less of O, and the balance of Cu.

[Claim 3] A copper alloy for conductive springs, comprising 0.5 to 4.0% of Ni, 0.1 to 1.0% of Si, 0.01 to 0.1% of Mg, 0.0015% or less of S, 0.0015% or less of O, further, as auxiliary components, 0.005 to 1.0% of one or more elements selected from P, B, As, Fe, Co, Cr, Al, Sn, Ti, Zr, In and Mn, and the balance of Cu.

[Claim 4] A copper alloy for conductive springs, comprising 0.5 to 4.0% of Ni, 0.1 to 1.0% of Si, 0.01 to 0.1% of Mg, 0.01 to 15% of Zn, 0.0015% or less of S, 0.0015% or less of O, further, as auxiliary components, 0.005 to 1.0% of one or more elements selected from P, B, As, Fe, Co, Cr, Al, Sn, Ti, Zr, In and Mn, and the balance of Cu.

From line 35 to 42 in column 7 on page (5)

Regarding the thermal peeling resistance of a tin plating, each specimen, which was plated with a 0.5 to 0.8 μm -thick copper underplating, further plated with a 1 to 1.5 μm -thick tin by electroplating, and then subjected to thermal reflow, was cut into 10 mm W \times 100 mm L, heated

at 150°C for a prescribed period (at every 100 hours), subjected to 90° bending back and forth one time in one side with a curvature of 0.3 mm (= the plate thickness), and the peripheral part of the bent part in the front and the rear faces was observed with a visual field enlarged 20 times, to confirm the occurrence of peeling of the plating.

Concise explanation with respect to JP-A-5-59468

JP-A-5-59468 shows effectiveness of Mg added to a Cu alloy to improve stress relaxation property. However, although stress relaxation property is improved by the addition of mg, this alloy material is poor in bending property, to cause cracks upon subjected to 180°-contact bending test, and the like. Accordingly, this alloy is necessarily improved in bending property to be used as a connector for automobile and the like.

Excerpted English translation of JP-A-1-180932

From line 4 to line 14 in column 1 on page (1)

[Claim]

[Claim 1] A highly tensile and highly electrically conductive copper alloy for pin grid array IC lead pins comprising 3.0 to 3.5 wt% of Ni, 0.5 to 0.9 wt% of Si, 0.05 to 5 wt% of Zn, 0.2 to 2.0 wt% of Sn, 0.001 to 0.1 wt% of Cr, 0.001 to 0.01 wt% of Mg, and the balance of Cu

and inevitable impurities, and having Vickers hardness of 200 or more and electrical conductivity of 30% IACS or more after a soft brazing treatment at lower than 450°C, and being excellent in the heat resistance, the stiffness strength, the repeated bendability and the noble metal platability.

From line 19 in lower right column on page (3) to line 2 in upper left column on page (4)

(6) The adhesion property of the Au plating was investigated by forming a 2 μm -thick Ni underlayer plating and a 3 μm -thick Au plating, heating at a brazing temperature of 425°C for 15 minutes, and then observing the occurrence of the blister with a magnifier.

Excerpted English translation of JP-A-6-100983

From line 1 to line 47 in column 1 on page (2)

[Claims]

[Claim 1] A metal foil for a TAB tape having high young modulus and high yield strength, wherein the metal foil is an alloy containing 20 to 95 wt% of Cu, 0.3 to 11 wt% of Al, 0.05 to 3.0 wt% of Mn, 0.005 to 3.5 wt% of Ti, 0.5 to 10 wt% of Cr, 0.001 to 1.5 wt% of Mo, and the balance of Fe and inevitable impurities, and has an aspect ratio of crystal grain size (the ratio of the crystal grains in the rolling direction and the perpendicular direction to

rolling) of 20 or less, and a foil thickness of 80 μm or less.

[Claim 2] The metal foil according to claim 1, wherein the weight ratio of Cr content to Fe content is 5.5 to 13.5 %.

[Claim 3] The metal foil according to claim 1 or 2, wherein the alloy further contains, as alloying elements, 0.005 to 8 wt% in total of one or more elements selected from Zr, Si, Ni, Zn, Sn, Nb, P, La, Ce, Y, V, Ca, Be, Mg or Hf, and 0.005 to 2 wt% in total of one or more of C or B.

[Claim 4] The metal foil according to any one of claims 1 to 3, wherein a surface of the metal foil is plated in a thickness of 0.001 to 0.02 μm , with a Ni, Cu, Ag, Au or their alloy plating, a Sn-Pb plating, or a tin plating in a single or a plurality of layers.

[Claim 5] A manufacturing method of a metal foil for a TAB tape having high young modulus and high yield strength, which foil has and slight characteristic anisotropy and is excellent in lead deformation resistance and heat resistant strength, wherein the method comprises steps of melting and casting an alloy with the composition according to any one of claims 1 to 3, and then hot-rolling the cast at a temperature in a range of 700 to 1,000°C, primarily cold-rolling the resulting plate with a reduction ratio of 50 to 95%, annealing the resulting

sheet at a temperature in a range of 800 to 1,000°C, and then secondarily cold-rolling the sheet with a reduction ratio of 1 to 70%, further subjecting the resulting foil to solution heat treatment at a temperature in a range of 700 to 1,000°C and then quenching the foil, and successively aging the foil at a temperature in a range of 350 to 650°C.

[Claim 6] A manufacturing method of a metal foil for a TAB tape having high young modulus and high yield strength, which foil has slight characteristic anisotropy and is excellent in lead deformation resistance and heat resistant strength, wherein the method comprises steps of melting and casting an alloy with the composition according to any one of claims 1 to 3, and then hot-rolling the cast at a temperature in a range of 700 to 1,000°C, primarily cold-rolling the hot-rolled plate with a reduction ratio of 50 to 90%, annealing the resulting sheet at a temperature in a range of 800 to 1,000°C and successively quenching the sheet, and then secondarily cold-rolling the sheet with a reduction ratio of 1 to 70%, and further successively aging the resulting foil at a temperature in a range of 350 to 650°C.

[Claim 7] The manufacturing method according to claim 5 or 6, wherein the secondary cold-rolling is carried out with a reduction ratio of 1 to 15%.

[Claim 8] The manufacturing method according to any one of claims 5 to 7, wherein the metal foil after the aging treatment is plated with a Ni, Cu, Ag, Au or their alloy plating, a Sn-Pb plating, or a tin plating with a thickness of 0.001 to 0.02 μm , in a single or a plurality of layers.

From line 33 to line 41 in column 14 on page (8)

[0024] Example 2

Table 5 shows the evaluation results of materials obtained by processing the specimens C, P shown in Table 1 and Table 2 with the following steps. That is, after 1 mm-thick metal plates obtained by hot-rolling were subjected to surface-grinding, the plates were subjected to primary cold-rolling with a reduction ratio of 35 to 96% to obtain sheets with a thickness of 0.055 mm, and the sheets were annealed at 1,000°C for 60 seconds, cooled at 100°C/min cooling rate with nitrogen gas, and then subjected to secondary cold-rolling of 1 to 75%.

[Table 5]

Sample No.	Specimens		Ratio of the primary cold rolling (%)	Ratio of the secondary cold rolling (%)	Aspect ratio	Yield strength (Kg/mm ²)		Conductivity (%ACS)		Workability	
						L	C	L	C	L	C
31	C	Comparative example	35	1	1.3	80	80	63	63	O	Δ
32	C	This invention	55	1	1.7	82	80	65	63	O	O
33	C	This invention	60	5	2.8	81	80	65	63	O	O
34	C	This invention	90	20	12.5	82	81	65	63	O	O
35	C	This invention	93	30	17.5	85	83	65	62	O	O
36	C	Comparative example	96	75	23.5	87	75	65	58	O	O
37	P	Comparative example	35	1	1.3	80	80	63	66	O	Δ
38	P	This invention	55	1	1.7	81	80	65	66	O	O
39	P	This invention	60	5	2.8	81	80	67	65	O	O
40	P	This invention	90	20	12.5	82	81	67	66	O	O
41	P	This invention	93	30	17.5	83	83	67	65	O	O
42	P	Comparative example	96	75	23.5	83	73	68	60	O	O

Concise explanation with respect to JP-A-61-127842

JP-A-61-127842 describes a Cu-Ni-Si-series alloy as a copper-series material that satisfies requirements under a severe condition of a high temperature and corrosive environment. However, such a Cu-Ni-Si-series alloy also has lapsed into an unusable state. More specifically, miniaturization of parts, for example, in a general box-type terminal, the reduction in tab width of a male terminal to be inserted of from about 2 mm to about 1 mm results in a decrease in the width of a spring part to about 1 mm, which is difficult to give a sufficient connection strength. Further, as correlated with the miniaturization, to secure connection strength at a spring part, many studies have been made on the structure of terminals. As a result, bending property required to a material has become more and more severe, and the conventional Cu-Ni-Si-series alloy often causes cracks at the bent portion. It is similarly applicable to stress relaxation property. Accordingly, the conventional Cu-Ni-Si-series alloy cannot be used for a long period of time, due to the increase of stress applied to the material and the change of environment to be used to become a higher temperature.

Excerpted English Translation of JP-A-11-43731

From line 1 in column 1, to line 40 in column 2, on page
(2)

[Claims]

[Claim 1] A high strength copper alloy excellent in stamping workability and suitable for silver plating, comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg, 0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C and the balance of Cu with inevitable impurities, wherein respective contents of Mg and S simultaneously satisfy the following inequalities (1) and (2):

$$0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \dots(1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \dots(2)$$

([Mg] means wt% of Mg and [S] means wt% of S, hereinafter the same.)

[Claim 2] A high strength copper alloy excellent in stamping workability and suitable for silver plating, comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg, 0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C and the balance of Cu with inevitable impurities, wherein respective contents of Mg and S simultaneously satisfy the following inequalities (1) and (2):

$$0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \dots(1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \dots(2),$$

and the alloy has an average crystal grain size in the direction of sheet thickness of 20 μm or less.

[Claim 3] A high strength copper alloy excellent in stamping workability and suitable for silver plating, comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg, 0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C, and 0.001-1.0 wt% in total amount of one kind, or two kinds or more of Be, B, Al, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Pb, Ca, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sb, Hf, and Ta as side component(s), and the balance of Cu with inevitable impurities, wherein respective Mg and S simultaneously satisfy the following inequalities (1) and (2):

$$0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \quad \dots (1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \quad \dots (2).$$

[Claim 4] A high strength copper alloy excellent in stamping workability and suitable for silver plating, comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg, 0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C, and 0.001-1.0 wt% in total amount of one kind, or two kinds or more of Be, B, Al, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Pb, Ca, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sb, Hf, and Ta as side component(s), and the balance of Cu with inevitable impurities, wherein respective Mg and S simultaneously satisfy the following

inequalities (1) and (2):

$$0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \quad \dots(1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \quad \dots(2),$$

and the alloy has an average crystal grain size in the direction of sheet thickness of 20 μm or less.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Technical Field to which the Invention belongs] The present invention relates to a high strength copper alloy excellent in stamping workability and silver plating suitability, which is used in electric/electronic parts such as a semiconductor lead frame, a terminal, a connector, a relay and a switch.

[0002]

[Prior Art] Cu-Ni-Si-series copper alloys have both strength and electrical conductivity and hence are widely used in electric/electronic parts such as a semiconductor lead frame, a terminal and a connector. In recent years, associated with miniaturization, light-weight and high integration of electric/electronic parts, contraction in lead distance of a lead frame or contraction of inter-electrode pitch of a connector is being attempted. This results in an increasing demand not only for attaining high strength and high electrical conductivity, but also for a material excellent in stamping workability (reduced

burrs and sagging after the stamping working) and causing no wear of a stamping die (see, for example, JP-A-2-66130). In addition, these electric/electronic parts are sometimes subjected to silver plating, and in accordance with increasing demand for improved reliability, silver plating suitability has become increasingly valued than conventionally (see, for example, JP-A-63-130739, 5-59468, and 8-319528).

[0003]

[Problems that the Invention is to Solve] In Cu-Ni-Si-series copper alloys for electric/electronic parts, Mg is used as an additive element for preventing the electrical conductivity from decreasing and for increasing the strength. Then, Mg, as described in JP-A-2-66130, has a great effect on stamping workability and reduction in the wear of a stamping die, however, it is known that Mg deteriorates silver plating suitability (generation of protrusions of silver plating) even with a very small quantity. An object of the present invention is to provide a high strength, Mg-containing Cu-Ni-Si-series copper alloy, reconciling both the stamping workability and silver plating suitability with each other, which properties have been hitherto considered mutually contradictory.

From lines 23 to 30 in column 4 on page (3)

[0014] (C) The present inventors have found that C has the effect of improving the stamping workability of Mg-containing Cu-Ni-Si-series copper alloy. However, if C content is less than 0.0003 wt%, the above effect is small, while if C content is over 0.01 wt%, the above effect is saturated and the hot workability of the alloy is deteriorated. Therefore, the content of C is set to 0.0003 to 0.01 wt%, and preferably 0.001 to 0.01 wt%.

From line 41 in column 4 on page (3), to line 3 in column 5 on page (4)

[0016] (Crystal grain size) The present inventors have found that in Mg-containing Cu-Ni-Si-series copper alloy, in particular, crystal grain size in the direction of sheet thickness is involved in the stamping workability. If the average crystal grain size in the direction of sheet thickness of the alloy in the state of a final sheet product is 20 μm or less, the stamping workability can be improved. Desirably, the average crystal grain size of the alloy is 15 μm or less. Even if the crystal grain size is over 20 μm in the stage of recrystallization, it is included within the above range when the crystal grains become flat during subsequent cold working to give an average crystal grain size in the direction of sheet thickness of 20 μm or less. Further, in the case of a so-called a fiber tissue, which is observed in a material

subjected to cold working with reduction of 90% or more in total after the recrystallization, crystal grains are difficult to observe. However, such a fiber tissue is also encompassed by the present invention.

Concise explanation with respect to JP-A-11-43731

JP-A-11-43731 describes a high strength copper alloy excellent in stamping workability and silver-plate adhesion property. However, the copper alloy in JP-A-11-43731 is applicable only in the use in which stamping workability and silver-plate adhesion property are required. Such an applicable use is different between JP-A-11-43731 and the present invention.

Further, the copper alloy in JP-A-11-43731 differs from the copper alloy of the present invention. That is, in the copper alloy of JP-A-11-43731, 0.0003-0.01 wt% of C is essential, but C is not an essential element in the alloy of the present invention. In JP-A-11-43731, the reason why C of the specific amount is essential is described.

Still further, the copper alloy in JP-A-11-43731 is limited to have a specific average crystal grain size in the direction of sheet thickness of 20 μm or less. This definition in JP-A-11-43731 differs from the definition of the crystal grain diameter in the alloy of the present invention.

In sum, the alloy of the present invention differs from that in JP-A-11-43731, in the points of the use, the constitution (alloy composition), and the definition of alloy's grain size.

Concise Explanation of documents

JP-A-63-130739

lines 6 to 12 in right lower column on page -191-

5 2. Claims

(1) A high strength and high conductivity copper alloy for semiconductor device lead material or conductive spring material, comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.1-1.0 wt% of Si, and the balance Cu with inevitable impurities in which S
10 content among the impurities is 0.0015 wt% or less.

Concise explanation with respect to JP-A-63-130739

JP-A-63-130739 describes a Cu-Ni-Si-series alloy relatively high in mechanical strength for use as the
15 contact point material. However, the Cu-Ni-Si-series alloy cannot serve as substitutes for the beryllium-copper alloy because mechanical strength and stress relaxation of the Cu-Ni-Si-series alloy is inferior to the beryllium-copper alloy.

20

JP-A-5-59468

lines 1 to 6 in column 1 on page (2)

[Claims]

[Claim 1] A copper alloy for conductive spring, comprising
25 0.5-4.0 % (means wt%, hereinafter the same) of Ni, 0.1-

1.0 % of Si, 0.01 to 0.1 % of Mg, 0.0015 % or less of S,
0.0015 % or less of O, and the balance Cu.

Concise explanation with respect to JP-A-5-59468

5 JP-A-5-59468 described a copper alloy for use as the
contact point material in which stress relaxation of the
Cu-Ni-Si-series alloy described, for example, in the above
JP-A-63-130739, is improved, by adding Mg. However, in
the copper alloy, the same level of stress relaxation as
10 the beryllium-copper alloy cannot be obtained by merely
adding Mg.

JP-A-11-43731

from line 1 in column 1, to line 40 in column 2, on page

15 (2)

[Claims]

[Claim 1] A high strength copper alloy excellent in
stamping workability and suitable for silver plating,
comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-
20 5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg,
0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C and the
balance Cu with inevitable impurities, wherein respective
contents of Mg and S simultaneously satisfy the following
inequalities (1) and (2):

25 $0.5[Mg] + [S] \geq 0.005 \dots(1)$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \quad \dots(2)$$

([Mg] means wt% of Mg and [S] means wt% of S, hereinafter the same.)

[Claim 2] A high strength copper alloy excellent in
 5 stamping workability and suitable for silver plating,
 comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-
 5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg,
 0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C and the
 balance Cu with inevitable impurities, wherein respective
 10 contents of Mg and S simultaneously satisfy the following
 inequalities (1) and (2):

$$0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \quad \dots(1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \quad \dots(2)$$

,and the alloy has an average crystal particle size in the
 15 direction of plate thickness of 20 μm or less.

[Claim 3] A high strength copper alloy excellent in
 stamping workability and suitable for silver plating,
 comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-
 5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg,
 20 0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C, and 0.001-1.0
 wt% in total amount of one kind, or two kinds or more of
 Be, B, Al, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Pb, Ca, Zr, Nb, Mo,
 Ag, In, Sb, Hf, and Ta as side component(s), and the
 balance Cu with inevitable impurities, wherein respective
 25 Mg and S simultaneously satisfy the following inequalities

(1) and (2):

$$0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \dots(1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}]. \dots(2)$$

[Claim 4] A high strength copper alloy excellent in
5 stamping workability and suitable for silver plating,
comprising 0.4-4.0 wt% of Ni, 0.05-1.0 wt% of Si, 0.001-
5.0 wt% of Sn, 0.1-5.0 wt% of Zn, 0.005-1.0 wt% of Mg,
0.0003-0.005 wt% of S, 0.0003-0.01 wt% of C, and 0.001-1.0
wt% in total amount of one kind, or two kinds or more of
10 Be, B, Al, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Pb, Ca, Zr, Nb, Mo,
Ag, In, Sb, Hf, and Ta as side component(s), and the
balance Cu with inevitable impurities, wherein respective
Mg and S simultaneously satisfy the following inequalities
(1) and (2):

$$15 \quad 0.5[\text{Mg}] + [\text{S}] \geq 0.005 \dots(1)$$

$$0.25[\text{Mg}] \geq [\text{S}] \dots(2)$$

,and the alloy has an average crystal particle size in the
direction of plate thickness of 20 μm or less.

[Detailed Description of the Invention]

20 [0001]

[Technical Field to which the Invention belongs] The
present invention relates to a high strength copper alloy
excellent in stamping workability and silver plating
suitableness, which is used in electric/electronic parts
25 such as a semiconductor lead frame, a terminal, a

connector, a relay and a switch.

[0002]

[Prior Art] Cu-Ni-Si-series copper alloys have both strength and electrical conductivity and hence are widely used in electric/electronic parts such as a semiconductor lead frame, a terminal and a connector. In recent years, associated with miniaturization, light-weight and high integration of electric/electronic parts, contraction in lead distance of a lead frame or contraction of inter-electrode pitch of a connector is being attempted. This results in an increasing demand not only for attaining high strength and high electrical conductivity but also for a material excellent in stamping workability (reduced burrs and sagging after the stamping working) and causing no wear of a stamping die (see, for example, JP-A-2-66130). In addition, these electric/electronic parts are sometimes subjected to silver plating and in accordance with increasing demand for improved reliability, silver plating suitability has become increasingly valued than conventionally (see, for example, JP-A-63-130739, 5-59468, and 8-319528).

[0003]

[Problems that the Invention is to Solve] In Cu-Ni-Si-series copper alloys for electric/electronic parts, Mg is used as an additive element for preventing the electrical

conductivity from decreasing and for increasing the strength. Then, Mg, as described in JP-A-2-66130, has a great effect on stamping workability and reduction in the wear of a stamping die, however, it is known that Mg is
5 deteriorated silver plating suitability (generation of protrusions of silver plating) even in a very small quantity. An object of the present invention is to provide a high strength, Mg-containing Cu-Ni-Si-series copper alloy, reconciling both the stamping workability
10 and silver plating suitability with each other that have been hitherto considered mutually contradictory.

lines 23 to 30 in column 4 on page (3)

[0014] (C) The present inventors have found that C has the effect of improving the stamping workability of Mg-
15 containing Cu-Ni-Si-series copper alloy. However, if C content is less than 0.0003 wt%, the above effect is small, while if C content is over 0.01 wt%, the above effect is saturated and the hot workability of the alloy is deteriorated. Therefore, the content of C is set to
20 0.0003 to 0.01 wt% and preferably 0.001 to 0.01 wt%.
from line 41 in column 4 on page (3), to line 3 in column 5 on page (4)

[0016] (Crystal particle size) The present inventors have found that in Mg-containing Cu-Ni-Si-series copper alloy,
25 in particular crystal particle size in the direction of

plate thickness is involved in its stamping workability.
If the average crystal particle size in the direction of
plate thickness of the alloy in the state of a final plate
product is 20 μm or less, the stamping workability can be
5 improved. Desirably, the average crystal particle size of
the alloy is 15 μm or less. Even if the crystal particle
size is over 20 μm in the stage of recrystallization, it
is included within the above range when the crystal
particles become flat during subsequent cold working to
10 give an average crystal particle size in the direction of
plate thickness of 20 μm or less. Further, in the case of
a so-called a fiber tissue, which is observed in a
material subjected to cold working of 90% or more in total
after the recrystallization, crystal particles are
15 difficult to observe. However, such a fiber tissue is
also encompassed by the present invention.

Concise explanation with respect to JP-A-11-43731

JP-A-11-43731 describes a high strength copper alloy
20 excellent in stamping workability and silver-plate
adhesion property. However, the copper alloy in JP-A-11-
43731 is applicable only in the use in which stamping
workability and silver-plate adhesion property are
required. Such an applicable use is different between JP-
25 A-11-43731 and the present invention.

Further, the copper alloy in JP-A-11-43731 differs from the copper alloy of the present invention. That is, in the copper alloy of JP-A-11-43731, 0.0003-0.01 wt% of C is essential, but C is not an essential element in the alloy of the present invention. In JP-A-11-43731, the reason why C of the specific amount is essential is described.

Still further, the copper alloy in JP-A-11-43731 is limited to have a specific average crystal particle size in the direction of sheet thickness of 20 μm or less. This definition in JP-A-11-43731 differs from the definition of the crystal grain diameter in the alloy of the present invention.

In sum, the alloy of the present invention differs from that in JP-A-11-43731, in the points of the use, the constitution (alloy composition), and the definition of alloy's grain size.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-222641

(43)Date of publication f application : 17.08.1999

(51)Int.Cl.

C22C 9/06
C22F 1/08
H01B 1/02
// C22F 1/00
C22F 1/00
C22F 1/00
C22F 1/00
C22F 1/00
C22F 1/00

(21)Application number : 10-033628

(22)Date of filing : 30.01.1998

(71)Applicant : FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE

(72)Inventor : HIRAI TAKAO
USAMI TAKAYUKI
YOSHIDA KOICHI
OYAMA YOSHIMASA

(54) COPPER ALLOY FOR ELCTRICALLY CONDUCTIVE SPRING AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a copper alloy combining excellent mechanical properties, conductivity, stress relaxation characteristics and bending workability.

SOLUTION: This copper alloy is the one having a compsn. contg., as essential components, by weight, 1.0 to 3.5% Ni, 0.2 to 0.9% Si, 0.01 to 0.20% Mg and 0.05 to 1.5% Sn, in which each content of S and O is limited to <0.005%, and the balance Cu with inevitable impurities, and the grain size thereof is regulated to >1 to 25 μ m. Thus, this is suitable for terminals, connector materials and switch materials. Furthermore, as for the method for producing it, after cold working, recrystallization treatment is executed at 700 to 920° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-222641

(43) 公開日 平成11年(1999) 8月17日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	F I
C 2 2 C 9/06		C 2 2 C 9/06
C 2 2 F 1/08		C 2 2 F 1/08
		G
		B
H 0 1 B 1/02		H 0 1 B 1/02
// C 2 2 F 1/00	6 3 0	C 2 2 F 1/00
		6 3 0 F
審査請求 未請求 請求項の数10 F D (全 13 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願平10-33628	(71) 出願人	000005290 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
(22) 出願日	平成10年(1998) 1月30日	(72) 発明者	平井 崇夫 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号古河 電気工業株式 会社内
		(72) 発明者	宇佐見 隆行 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号古河 電気工業株式 会社内
		(72) 発明者	吉田 浩一 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号古河 電気工業株式 会社内
		(74) 代理人	弁理士 煤孫 耕郎
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性ばね用銅合金及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 優れた機械的特性、伝導性、応力緩和特性と曲げ加工性を兼ね備えた銅合金を提供する。

【解決手段】 主成分としてNiを1.0～3.5wt%、Siを0.2～0.9wt%、Mgを0.01～0.20wt%、Snを0.05～1.5wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金であり、端子、コネクタ材、スイッチ材に適するものである。また製造方法は冷間加工後に再結晶処理を700～920℃で行うものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 主成分としてNiを1.0～3.5wt%、Siを0.2～0.9wt%、Mgを0.01～0.20wt%、Snを0.05～1.5wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避の不純物からなり、その結晶粒度が1 μ mを越え25 μ m以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金。

【請求項2】 主成分としてNiを1.0～3.5wt%、Siを0.2～0.9wt%、Mgを0.01～0.20wt%、Snを0.05～1.5wt%、Znを0.2～1.5wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避の不純物からなり、その結晶粒度が1 μ mを越え25 μ m以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の銅合金に、さらに0.005～0.3wt%Ag、0.01～0.5wt%Mn、それぞれ0.005～0.2wt%のFe、Cr、0.05～2.0wt%Co、0.005～0.1wt%Pの中から選ばれ1種または2種以上を総量で0.005wt%～2.0wt%含むことを特徴とする導電性ばね用銅合金。

【請求項4】 請求項1又は2に記載の銅合金に、さらに0.005～0.1wt%Pb、0.005～0.03wt%Biの1種または2種を総量で0.005～0.13wt%含むことを特徴とする導電性ばね用銅合金。

【請求項5】 請求項1又は2に記載の銅合金に、さらに0.005～0.3wt%Ag、0.01～0.5wt%Mn、それぞれ0.005～0.2wt%のFe、Cr、0.05～2.0wt%Co、0.005～0.1wt%Pの中から選ばれ1種または2種以上、及び0.005～0.1wt%Pb、0.005～0.03wt%Biの1種または2種を総量で0.005wt%～2.0wt%含むことを特徴とする導電性ばね用銅合金。

【請求項6】 端子、コネクタ材、スイッチ材のいずれかに用いられるものであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の導電性ばね用銅合金。

【請求項7】 冷間加工後に再結晶処理を700～920℃で行うことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の導電性ばね用銅合金の製造方法。

【請求項8】 冷間加工後に再結晶処理を700～920℃で行った後に、420～550℃で時効処理を行うことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の導電性ばね用銅合金の製造方法。

【請求項9】 冷間加工後に再結晶処理を700～920℃で行い、さらに25%以下の冷間加工を行った後に、420～550℃で時効処理を行うことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の導電性ばね用銅合金の製造方法。

【請求項10】 冷間加工後に再結晶処理を700～920℃で行い、次に25%以下の冷間加工、420～550℃での時効処理を行った後に、さらに25%以下の冷間加工、及び低温焼鈍を行うことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の導電性ばね用銅合金の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、導電性ばね用銅合金及びその製造方法に関し、特に端子・コネクタ材、スイッチ材等に適する導電性ばね用銅合金とその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来より端子、コネクタ用材料として銅合金が用いられ、Cu-Zn系合金、耐熱性に優れたCu-Fe系合金、Cu-Sn系合金が多く用いられている。特に、自動車等の用途では安価なCu-Zn系合金が多く使用されているが、近年の自動車用端子、コネクタは小型化傾向が著しく、またエンジンルーム内などの過酷な環境にさらされる場合が多いため、Cu-Zn系合金ではもちろんのこと、Cu-Fe系合金、Cu-Sn系合金でも対応出来なくなってきたのが現状である。

【0003】 このように、使用されている環境の変化に伴い、端子、コネクタ用材料に求められる特性もより厳しくなっている。このような用途に使用される銅合金には、応力緩和特性、機械的強度、熱伝導性、曲げ加工性、耐熱性、Snメッキの接続信頼性、マイグレーション特性など多岐に渡っているが、特に機械的強度や応力緩和特性、熱・電気の伝導性、曲げ加工性が重要な特性である。

【0004】 これらの厳しい要求特性を満たす銅系材料として、Cu-Ni-Si系合金が注目されており、例えば、特開昭61-127842号公報が知られている。しかしながら、このようなCu-Ni-Si系合金でも使用に耐え得ない状態に陥っている。具体的には部品の小型化、例えば一般的な箱型端子において、挿入されるオス端子のタブ幅が約2mmである090端子から約1mmである040端子へ小型化されると、バネ部の幅が1mm程度であり、このように部品が小型化されると、十分な接続強度を得ることが困難になっている。また、小型化に関連してバネ部での接続強度を確保するために、端子の構造にも多くの工夫がなされているが、その結果、材料に要求される曲げ加工性もより厳しくなっており、従来のCu-Ni-Siでは曲げ部にクラックが生じる場合も多い。応力緩和特性も同様であり、材料に負荷される応力の増大、使用環境の高温化により従来のCu-Ni-Si系合金では長時間の使用は不可能な状況である。

改善するためにMgの添加が有効であり、例えば、特開昭61-250134号公報、特開平5-59468号公報などにもMgの有効性が示されている。しかしながらMg添加により応力緩和特性は向上するものの、曲げ加工性が劣化し、180°密着曲げには耐え得ないものであり自動車コネクタなどに使用するには曲げ加工性の改善が不可欠である。また曲げ加工性を改善するための検討もされているが、これは強度の低い材料であるために所望の特性が得られないものであった。さらに、熱・電気の伝導性が悪いと、応力緩和特性が良くとも、自己の発熱で応力緩和を促進するため、伝導性と応力緩和特性のバランスが重要である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上述したように、曲げ加工性、応力緩和特性等について検討し、厳しい要求特性を満たす銅系材料が提案されているが、本発明は、優れた機械的特性、伝導性、応力緩和特性と曲げ加工性を兼ね備えた銅合金であり、端子、コネクタに好適な銅合金を提供するものである。

【0007】

【問題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するもので、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。また、上記構成において、本発明の特性に悪影響を与えない範囲で、他の添加元素、例えば0.2%未満のZnを添加しても差し支えないものである。また、本発明は、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%、Znを0.2~1.5wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。

【0008】また、本発明は、上記の銅合金に、さらにAg、Mn、Fe、Cr、Co、Pの中から選ばれ1種または2種以上を総量で0.005wt%~2.0wt%含むことを特徴とする銅合金である。具体的には、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%含み、さらに0.005~0.3wt%Ag、0.01~0.5wt%Mn、それぞれ0.005~0.2wt%のFe、Cr、0.05~2.0wt%Co、0.005~0.1wt%Pの中から選ばれ1種または2種以上を総量で0.005wt%~2.0wt%含むことを特徴とする銅合金である。

0.5wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。また、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%、Znを0.2~1.5wt%含み、さらに0.005~0.3wt%Ag、0.01~0.5wt%Mn、それぞれ0.005~0.2wt%のFe、Cr、0.05~2.0wt%Co、0.005~0.1wt%Pの中から選ばれ1種または2種以上を総量で0.005wt%~2.0wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。

【0009】また、本発明は、上記の銅合金に、さらにPb、Biの1種または2種を総量で0.005~0.13wt%含むことを特徴とする銅合金である。具体的には、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%含み、さらに0.005~0.1wt%Pb、0.005~0.03wt%Biの1種または2種を総量で0.005~0.13wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。また、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%、Znを0.2~1.5wt%含み、さらに0.005~0.1wt%Pb、0.005~0.03wt%Biの1種または2種を総量で0.005~0.13wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免の不純物からなり、その結晶粒度が1μmを越え25μm以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。

【0010】また、上記の銅合金に、さらにAg、Mn、Fe、Cr、Co、Pの中から選ばれ1種または2種以上、及びPb、Biの1種または2種を総量で0.005wt%~2.0wt%含むことを特徴とする銅合金である。具体的には、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%含み、さらに0.005~0.3wt%Ag、0.01~0.5wt%Mn、それぞれ0.005~0.2wt%のFe、Cr、0.05~2.0wt%Co、0.005~0.1wt%Pの中から選ばれ1種または2種以上、及び0.005~0.1wt%Pb、0.005~0.03wt%Biの1種または2種を総量で0.005wt%~2.0wt%含むことを特徴とする銅合金である。

それ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免的な不純物からなり、その結晶粒度が $1\mu\text{m}$ を超え $25\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。また、主成分としてNiを1.0~3.5wt%、Siを0.2~0.9wt%、Mgを0.01~0.20wt%、Snを0.05~1.5wt%、Znを0.2~1.5wt%含み、さらに0.005~0.3wt%Ag、0.01~0.5wt%Mn、それぞれ0.005~0.2wt%のFe、Cr、0.05~2.0wt%Co、0.005~0.1wt%Pの中から選ばれ1種または2種以上、及び0.005~0.1wt%Pb、0.005~0.03wt%Biの1種または2種を総量で0.005wt%~2.0wt%含み、S、O含有量をそれぞれ0.005wt%未満に制限し、残部Cu及び不可避免的な不純物からなり、その結晶粒度が $1\mu\text{m}$ を超え $25\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする導電性ばね用銅合金である。

【0011】また、本発明の上記銅合金は、端子、コネクタ材、スイッチ材のいずれかに用いられるものであることを特徴とするものである。また、本発明は、冷間加工後に再結晶処理を $700\sim 920^\circ\text{C}$ で行うことを特徴とする導電性ばね用銅合金の製造方法である。また、冷間加工後に再結晶処理を $700\sim 920^\circ\text{C}$ で行った後に、 $420\sim 550^\circ\text{C}$ で時効処理を行うことを特徴とする導電性ばね用銅合金の製造方法である。また、冷間加工後に再結晶処理を $700\sim 920^\circ\text{C}$ で行い、さらに25%以下の冷間加工を行った後に、 $420\sim 550^\circ\text{C}$ で時効処理を行うことを特徴とする導電性ばね用銅合金の製造方法である。さらに、冷間加工後に再結晶処理を $700\sim 920^\circ\text{C}$ で行い、次に25%以下の冷間加工、 $420\sim 550^\circ\text{C}$ での時効処理を行った後に、さらに25%以下の冷間加工、及び低温焼鈍を行うことを特徴とする導電性ばね用銅合金の製造方法である。

【0012】

【作用】本発明の銅合金は、Cuマトリックス中にNiとSiの化合物を析出させ、適当な機械的強度及び熱・電気導電性を有する銅合金に、Sn、Mg、Znを特定量添加し、S、O含有量を制限して、かつ結晶粒度を $1\mu\text{m}$ を超え $25\mu\text{m}$ 以下として応力緩和特性と曲げ加工性を改善することを骨子としている。本発明者らは、この銅合金成分の含有量を詳細に規定することで実用的に優れた特性を有する導電性ばね用銅合金、特に端子、コネクタ用として優れた特性を有する材料を実現させることができることを見だし、その結果本発明の銅合金を得たものである。

【0013】以下に本発明の銅合金の成分限定理由を説明する。CuにNiとSiを含有させるとNi-Si化合物を作り、これをCu中に析出させ強度及び導電率を向上させるのである。Ni量は1.0...と0.3wt%で

Ni量が3.5wt%を超えると铸造、熱間加工時に強度上昇に寄与しない析出が生じ含有量に見合う強度を得ることができないばかりか、熱間加工性、曲げ加工性にも悪影響を与えることになる。Si量は析出するNiとSiの化合物が Ni_2Si 相であると考えられるため、Ni量を決定すると最適なSi含有量が決まる。Si量が0.2wt%未満であるとNi量が少なくなると同様十分な強度を得ることができない。逆にSi含有量が0.9wt%を超えるとNi量が多い場合と同様の問題が生ずる。好ましくは、Niを1.7~2.8wt%、Siを0.4~0.7wt%に調整することが望ましい。

【0014】Mg、Snは本発明の銅合金を構成する重要な添加元素である。これらの元素は相互に関係しあって良好な特性バランスを実現している。次に、これら元素の限定理由を説明する。Mgは応力緩和特性を大幅に改善するが、曲げ加工性には悪影響を及ぼす。応力緩和特性の観点からは、0.01wt%以上で含有量が多いほどよい。逆に曲げ加工性の観点からは、含有量が0.20wt%を超えると良好な曲げ加工性を得ることは困難である。このような観点から、Mgの含有範囲は0.01~0.20wt%において良好なバランスを示す。曲げ加工性の観点からより好ましいMgの含有範囲は、0.01~0.1wt%である。

【0015】さらに、Snを加えることにより、良好な曲げ加工性を保ったまま、より応力緩和特性を改善できることを見出した。Snは、応力緩和特性の改善効果を有するものの、その効果はMgほど大きくないが、Mgと相互に関係しあって良好な特性バランスを示すものである。Snを1.5wt%を超えて含有すると、熱及び電気の伝導性が劣化し、実用上問題を来す。Sn含有量はMg量との兼ね合いもあるが、0.05~1.5wt%で良好な特性バランスを示す。具体的には、Mgが0.01~0.05wt%の場合には、Snは0.8~1.5wt%が好ましく、Mg量が0.05~0.1wt%の場合には、Snは0.05~0.8wt%が好ましい。

【0016】Znは応力緩和特性に寄与しないが、曲げ加工性を改善することができる。Znを0.2~1.5wt%、好ましくは0.3~1.0wt%含有することにより、Mgを最大0.20wt%まで含有させても実用上問題ないレベルの曲げ加工性を達成できる。またZnはSnメッキやハンダメッキの耐熱剥離性、マイグレーション特性を改善する効果を有し、打ち抜き加工性を改善する作用も有し、実用上の観点からZnを0.2wt%、好ましくは0.3wt%以上含有させることが望ましい。打ち抜き加工性を改善する元素としては、Pb、Biがあるが、Pb、Biは多量に添加すると熱間加工時に問題が生ずるが、本発明の銅合金に添加する

ある。その上限は熱・電気の伝導性を考慮し、1.5wt%、好ましくは1.0wt%である。なお、本実施例からも、Mgとの共添でより良い傾向にあることが示されている。

【0017】以上、Mg、Sn、Znの添加範囲を限定した理由を詳述したが、これらの元素の限定範囲内でそれぞれ最大含有量とすることは好ましくない。実用上、最もバランスの良好な含有量の範囲は、Mg:0.05~0.15wt%、Sn:0.2~0.5wt%、Zn:0.3~0.8wt%である。

【0018】次に、Ag、Mn、Fe、Cr、Co、Pの含有量の範囲を限定した理由を説明する。Ag、Mn、Fe、Cr、Co、Pは、加工性を改善するという点で類似の機能を有しているものであり、Ag、Mn、Fe、Cr、Co、Pの中から選ばれ1種または2種以上を0.005wt%~2.0wt%含有させるものである。

【0019】Agは、耐熱性を上げ、強度を上昇させると同時に、結晶粒の粗大化を阻止し、曲げ加工性を改善することができる。従来より、Cu-Ni-Si系合金の強度を上昇させるために種々の第三元素を添加することが試みられている処であるが、それらは大幅に導電率を下げたり、曲げ成形性が劣化し、電子機器用途として好ましくない特性が現れるものであった。本発明は、強度を向上し、且つその他の特性に悪影響を及ぼさない元素の検討を繰り返した結果、Agが有効であることを見いだしたものである。含有量が0.005wt%未満であるとその効果が現れず、逆に0.3wt%を超えて含有すると特性上の悪影響はないものの、コスト高となるので、Agの最適含有量は0.005~0.3wt%であり、より好ましくは0.005~0.1wt%である。

【0020】Mnは、強度を上昇させると同時に熱間加工性を改善する効果があり、0.01wt%未満であるとその効果が小さく、0.5wt%を超えて含有しても、含有量に見合った効果が得られないばかりでなく、伝導性を劣化させる。よってMnの最適含有範囲は、0.01~0.5wt%であり、より好ましくは0.03~0.3wt%である。

【0021】Fe、Crは、Siと結合し、Fe-Si化合物、Cr-Si化合物を形成し強度を上昇させる。またNiとの化合物を形成せずに銅マトリックス中に残存するSiをトラップし、導電性を改善する効果がある。Fe-Si化合物、Cr-Si化合物は析出硬化能が低いので、多くの化合物を生成させることは得策でない。また、0.2wt%を超えて含有すると曲げ加工性が劣化してくる。これらの観点から、Fe、Crを含有する場合の添加量は、0.005~0.2wt%である。

し、機械的強度を向上させる。Coは、Niに比し高価であるため、本発明ではCu-Ni-Si系合金を利用しているが、コスト的に許されるのであれば、Cu-Co-Si系やCu-Ni-Co-Si系を選択しても良い。Cu-Co-Si系は時効析出させた場合に、Cu-Ni-Si系より機械的強度、導電性共に僅かに良くなる。したがって熱・電気の伝導性が重視される部材には有効である。また、Co-Si化合物は析出硬化能が僅かに高いので、応力緩和特性も若干改善される傾向にある。これらの観点から、Coを添加する場合の最適添加量は、0.005~2.0wt%である。

【0023】Pは、強度を上昇させると同時に導電性を改善する効果を有する。多量の含有は粒界析出を助長して曲げ加工性を低下させる。よってPを添加する場合の最適含有範囲は、0.005~0.1wt%であり、より好ましくは0.005~0.05wt%である。これらを2種以上同時に添加する場合には、求められる特性に応じて適宜決定すれば良いが、耐熱性、Snメッキ、ハンダメッキ耐熱剥離性、伝導性などの観点から総量で0.005~2.0wt%とした。

【0024】次に、Pb、Biの含有量の範囲を限定した理由を説明する。Pb、Biは、打ち抜き加工性を改善するもので、Pb、Biの1種または2種を0.005~0.13wt%含有するものである。Pbは打ち抜き加工性を改善する添加元素である。近年のプレス高速化にともない、端子用材料にはより優れた加工性が求められている。Pbは銅マトリックス中に分散し、破壊の起点になるため打ち抜き加工性を改善する。Pb量が0.005wt%未満であると特性改善効果がなく、0.1wt%を超えて添加すると熱間加工性を低下させるばかりでなく、曲げ加工性をも劣化させるため、0.005~0.1wt%が最適であり、より好ましくは0.005~0.05wt%である。Biも打ち抜き加工性を改善する添加元素である。0.005wt%未満であると特性改善効果が小さく、0.03wt%を超えて添加するとPbと同様の特性低下を来す。よってBiの最適含有範囲は、0.005~0.03wt%であり、より好ましくは0.005~0.02wt%である。

【0025】これらAg、Mn、Fe、Cr、Co、Pの中から選ばれ1種または2種以上、及びPb、Biの1種または2種を同時に含有する場合には、求められる特性に応じて適宜決定すれば良いが、耐熱性、Snメッキ、ハンダメッキ耐熱剥離性、伝導性などの観点から総量で0.005~2.0wt%とした。

【0026】次に、S、O含有量を0.005wt%未満に制限した理由を説明する。通常、工業的な銅材料にはS、O₂等が微量含まれるが、本発明はこれらの含

【0030】また、冷間加工後に再結晶処理（溶体化）を700～920℃で行い、さらに冷間加工（25%以下）を行った後に420～550℃で時効処理を行うものである。後に述べる実施例では、溶体化後直ぐに時効処理を行い、その後、冷間加工（25%以下）を行った後に420～550℃で時効処理を行う。

C n n (n+1) 0/ C n J .. + 制離析 訂仁

性評価を行った。

【0035】結晶粒度、即ち結晶粒の大きさは、JIS H0501に準じ、比較法と切断法を併用し観察を行った。比較法では試験片を顕微鏡観察（75倍または200倍）して測定した。切断法では加工方向に平行な板厚断面で測定を行った。引っ張り強度はJIS Z2241で、熱・電気の伝導性を示す値として、導電率をJIS H0505に準じて測定した。

【0036】曲げ加工性の評価は、内側曲げ半径がORの180°密着曲げを行った。評価の指標は、

- A. しわもなく良好
- B. 小さなしわが観察される
- C. 大きなしわが観察されるが、クラックには至っていない
- D. 微細なクラックが観察される
- E. 明瞭にクラックが観察される

の5段階で評価し、評価C以上を実用上問題の無いレベルと判断した。

【0037】応力緩和特性の評価は、日本電子材料工業会標準規格であるEMAS-3003に準拠して行った。ここで片持ちブロック式を採用し、表面最大応力が450N/mm²となるように負荷応力を設定し、150℃の恒温槽で試験を行った。表4～表6には、1000hr試験後の緩和率（S. R. R）で示した。

【0038】応力緩和の試験方法の片持ちブロック法について、図1（a）（b）（c）に示す。図1（a）は斜視図、（b）は側面図であり、サンプル（1）の一方は基台（2）に保持部材（3）で片持ち状態に支持し、もう一方はブロック（4）によりサンプル（1）に歪み

δo（初期たわみ変位）を与えた状態にする。この状態でサンプル（1）を150℃に所定時間（本実施例では1000hr）加熱する。所定時間経過後、図1（c）の側面図に示すように、ブロック（4）を取り除いた状態での歪みδt（永久たわみ変位）を測定し、応力緩和率（%）は次式で求めた。

$$\text{応力緩和率 (\%)} = (\delta t / \delta o) \times 100$$

なお、初期たわみ変位は、表面最大応力が所定の値（450N/mm²）になるよう、ヤング率、板厚等から計算するものである（計算方法はEMAS-3003による）。

【0039】Snメッキの加熱剥離性は、1μmの光沢Snメッキを施した試験片を150℃×1000時間の大気加熱をしてから、180度の密着曲げ、および曲げ戻しをした後、その部分のメッキ剥離を目視にて評価した。半田の剥離が認められる場合、表4～6に「有」と記した。

【0040】打ち抜き性は、金型（SKD11製）で打ち抜き試験（1mm×5mmの角孔を設ける）を行うことにより調べた。そして5001回目から10000回目の打ち抜き分から20個無作為に抽出したサンプルの打ち抜き面を観察して破断部の厚さを測定した。表4～6には試験片の厚さに対する破断部の厚さの割合の平均値を%表示で示す（表中でF. A. Rと表示）。バリ測定についても同様に、5001回目から10000回目の打ち抜き部分から20個無作為に抽出したサンプルのバリの高さを接触式形状測定機で求め、平均値を表に記載した。

【表1】

	No	Ni	Si	Mg	Sn	Zn	S	O	その他	結晶粒度
本発明例	1	1.5	0.34	0.07	0.31	0.49	0.002	0.001		5
	2	1.9	0.48	0.08	0.30	0.48	0.002	0.001		↑
	3	2.5	0.60	0.08	0.30	0.49	0.002	0.001		↑
	4	3.0	0.75	0.07	0.31	0.50	0.002	0.001		↑
	5	2.0	0.48	0.04	0.30	0.50	0.002	0.001		↑
	6	1.9	0.48	0.03	0.85	0.49	0.002	0.001		↑
	7	2.0	0.47	0.08	0.87	0.50	0.002	0.001		↑
	8	2.0	0.46	0.16	0.29	0.09	0.002	0.001		↑
	9	2.0	0.47	0.16	0.30	1.10	0.002	0.001		↑
	10	2.0	0.48	0.08	0.30	1.07	0.002	0.001		↑
	11	1.9	0.46	0.04	0.87	0.10	0.002	0.001		↑
	12	2.0	0.48	0.07	0.85	1.10	0.002	0.001		↑
	13	1.5	0.47	0.08	0.33	0.50	0.002	0.001	Co0.5	↑
	14	1.9	0.48	0.08	0.31	0.49	0.002	0.001	Co0.1	↑
	15	2.0	0.48	0.08	0.32	0.49	0.002	0.001	Ag0.03	↑
	16	2.0	0.48	0.07	0.32	0.49	0.002	0.001	Pb0.03	↑
	17	2.0	0.47	0.08	0.33	0.50	0.002	0.001	Cr0.007	↑
	18	1.9	0.48	0.07	0.32	0.48	0.002	0.001		2
	19	2.0	0.48	0.06	0.33	0.49	0.002	0.001		10
	20	2.0	0.46	0.08	0.33	0.50	0.002	0.001		15

【表2】

	No	Ni	Si	Mg	Sn	Zn	S	O	その他	結晶粒度
比較例	22	0.8	0.18	0.08	0.34	0.50	0.002	0.001		5
	23	3.8	0.95	0.08	0.33	0.49	0.002	0.001		↑
	24	2.0	0.47	0.003	0.33	0.49	0.002	0.001		↑
	25	2.0	0.48	0.002	0.99	0.50	0.002	0.001		↑
	26	1.9	0.47	0.25	0.33	1.25	0.002	0.001		↑
	27	2.0	0.48	0.08	0.002	0.50	0.002	0.001		↑
	28	2.0	0.48	0.08	2.04	0.50	0.002	0.001		↑
	29	2.1	0.47	0.08	0.31	5.09	0.002	0.001		↑
	30	2.0	0.47	0.07	0.33	0.49	0.002	0.001	Fe0.35	↑
	31	1.9	0.48	0.08	0.32	0.48	0.002	0.001	Pb0.25	↑
	32	1.9	0.46	0.09	0.33	0.49	0.011	0.001		↑
	33	2.0	0.48	0.08	0.32	0.50	0.002	0.007		↑
	34	2.0	0.47	0.08	0.31	0.50	0.002	0.001		≤1
	35	2.0	0.48	0.08	0.32	0.49	0.002	0.001		30

【表3】

	No	Ni	Si	Mg	Sn	Zn	S	O	その他	結晶粒度
比較例	36	2.0	0.47	0.07	0.002	0.49	0.002	0.001	Cr0.10	5
	37	1.9	0.48	0.08	0.001	0.48	0.002	0.001	Mn0.39	↑
	38	2.0	0.48	0.08	0.002	0.50	0.002	0.001	B0.008	↑
	39	2.0	0.47	0.08	0.001	0.50	0.002	0.001	Al0.50	↑
	40	2.0	0.48	0.08	0.001	0.50	0.002	0.001	Ti0.10	↑
	41	2.0	0.48	0.08	0.002	0.49	0.002	0.001	In0.10	↑
従米例	42	2.5	0.60	—	—	—	—	—		
	43	1.9	0.50	—	0.4	0.9	—	—		
	44	2.7	0.65	0.17	—	—	—	—		

【表4】

	No	TS N/mm ²	EI %	EC %IACS	曲げ 加工性	S. R. R %	Sn/Pb 剥離性	打ち抜き性	
								F. A. R(%)	バリ(μm)
本 発 明 例	1	610	16	39	B	22	剥離無し	42	9
	2	670	16	39	B	18	↑	45	6
	3	680	15	38	B	17	↑	46	6
	4	680	14	38	C	17	↑	50	5
	5	660	16	40	B	22	↑	44	7
	6	680	16	33	B	18	↑	46	7
	7	680	15	32	B	14	↑	47	8
	8	670	16	38	C	14	↑	47	6
	9	670	16	36	B	14	↑	51	4
	10	670	16	37	B	18	↑	50	4
	11	680	15	33	C	18	↑	41	10
	12	680	16	31	B	14	↑	54	3
	13	710	15	42	B	15	↑	49	4
	14	700	16	40	B	16	↑	47	4
	15	680	16	39	B	18	↑	45	7
	16	670	16	39	B	19	↑	55	2
	17	660	15	41	B	19	↑	45	8
	18	680	14	39	C	20	↑	46	6
	19	670	16	39	B	18	↑	44	7
	20	670	16	39	B	18	↑	41	9
	21	660	13	39	C	19	↑	39	11

【表5】

	No	TS N/mm ²	EI %	EC %IACS	曲げ 加工性	S. R. R %	Sn/Pb 剥離性	打ち抜き性	
								F. A. R(%)	バリ(μm)
比 較 例	22	480	19	51	A	—(*)	剥離無し	31	19
	23	680	14	38	D	17	↑	49	4
	24	670	16	40	B	33	↑	40	11
	25	680	16	32	B	31	↑	42	11
	26	670	15	34	D	13	↑	58	2
	27	670	16	42	B	24	↑	45	5
	28	690	15	23	B	13	↑	46	6
	29	680	17	29	B	18	↑	56	2
	30	530	18	43	D	—(*)	↑	37	17
	31	熱間加工中に割れが生じたため製造中止							
	32	熱間加工中に割れが生じたため製造中止							
	33	670	10	40	D	23	剥離無し	46	6
	34	680	12	39	D	22	↑	45	8
	35	650	9	39	D	25	↑	40	12

【表6】

	No	TS N/mm ²	EI %	EC %IACS	曲げ 加工性	S.R.R %	Snメッキ 剥離性	打ち抜き性	
								F.A.R (%)	平均 (μm)
比較例	36	650	17	42	B	24	剥離無し	44	8
	37	670	15	35	B	25	↑	46	7
	38	670	16	40	B	25	↑	41	11
	39	670	16	35	B	23	↑	47	8
	40	660	15	40	B	26	↑	46	9
	41	680	16	39	B	24	↑	44	10
従来例	42	670	17	46	B	34	剥離有り	38	13
	43	650	16	38	B	33	剥離無し	37	13
	44	680	11	44	D	19	剥離有り	40	11

【0041】表4から明らかなように、本発明例1～21は、TS（引張り強度）、EI（伸び）、EC（導電率）、曲げ加工性、S.R.R（応力緩和率）、Snメッキ剥離性、打ち抜き性の各種特性の何れも優れた特性を示していることが判る。

【0042】一方、Ni-Si量の少ない比較例No. 22は、目的とする強度が得られず、打ち抜き加工性も他の材料と比較して劣っている。逆にNi-Si量の多い比較例No. 23は、Ni-Si量の少ない本発明例No. 4と比較し強度の点では差はないが、曲げ加工性では劣化傾向を示した。即ち、本発明で規定する量以上のNi-Siを添加することは、曲げ加工性が劣るので、端子・コネクタ用として不適である。

【0043】Mgの添加量が少ない比較例No. 24は、本発明例のNo. 2、No. 5と比較し、応力緩和特性が大幅に劣っている。これと同じ理由で比較例No. 25は本発明例No. 6、No. 7より劣っている。このことは、従来のCu-Ni-Si合金（従来例No. 42）にSnを単独で添加しても、応力緩和特性には大きな改善効果を期待できないことを示すものであり、従来のSn入りCu-Ni-Si合金（従来例No. 43）の特性と一致する。

【0044】Mgの添加量が、本発明の規定量以上である比較例No. 26は、曲げ加工性が劣化している。これは端子・コネクタ材としては不適である。曲げ加工性を若干改善できるZnを1wt%以上添加しても良好な曲げ加工性は確保できなかった。Snの添加量が少ない比較例No. 27は、本発明例のNo. 2と比較し、応力緩和特性の点で劣っている。逆にSnの添加量が多い比較例No. 28は、Mgの効果と相まり、今回製造を行った中で最も優れた応力緩和特性を示した組成の一つであった。しかしながら、導電率が最も低くなり、バランス的に優れているとは言えない。Znの添加量が多い比較例No. 29も導電率が低くなり、特性バランスに優れない。

【0045】Feの添加量が規定量以上である比較例N

及ぼした。Pbの添加量を多くした比較例No. 31は熱間加工中に割れを生じ、正常に製造することが出来なかった。その他、Sが本発明範囲外にある比較例No. 32は、熱間加工時に割れが生じ、その後の特性評価を行えなかった。また、Oが多い比較例No. 33は、Mgの酸化物が生成しており、曲げ加工性が劣化した。

【0046】比較例No. 34は、再結晶させるための焼鈍を680℃×30sで行った。その結果、平均結晶粒は1μm以下で、比較的大きな結晶粒と小さな結晶粒が混在する組織となった。不均一な組織のため、曲げ加工性を行う試験片を採取する場所によっては、クラックを生ずる結果となった。逆に、比較例No. 35は930℃×30sで熱処理を行ったため、結晶粒はおよそ30μmとなった。粗大な結晶粒となったため、曲げ加工性に悪影響を及ぼすばかりでなく、若干応力緩和特性も低下した。

【0047】また比較例No. 36～No. 41は、Cu-Ni-Si-Mg-Zn合金にSn以外の元素を添加した比較例である。これらいずれの合金の応力緩和特性もSnの添加量が少ない比較例No. 27と同程度の応力緩和特性であり、これらの元素の添加は応力緩和にはほとんど寄与しないことが判る。

【0048】次に、従来から存在する合金についてみると、従来例No. 42は、Cu-Ni-Si合金であり、その他の添加元素は含まれていない。この場合、応力緩和特性が良くない点と、Znを含まないため、Snメッキの加熱剥離性に問題がある。従来例No. 43は先述のとおり、Cu-Ni-Si系合金にSnとZnを添加した材料である。Snメッキの加熱剥離性は改善されているが、応力緩和特性は従来例No. 41と同等であり不十分である。

【0049】No. 44は、Mgを添加し、応力緩和特性の改善を図った材料である。Mgの効果により応力緩和特性は改善されているが、曲げ加工性に問題がある。この従来例No. 44と同等の応力緩和特性と良好な曲げ加工性を得るためには、本発明例No. 2のように、

より、Snメッキの加熱剥離性も改善される。

【0050】

【実施例2】本発明の第2の実施例を表7、表8で説明する。第2の実施例は、上記実施例1に示した本発明例No. 2の組成からなる合金を、表7よる工程で製造して、表8に示すように、TS（引張り強度）N/m

m²、EI（伸び）%、EC（導電率）% IACS、曲げ加工性、S. R. R（応力緩和率）%、Snメッキ剥離性、打ち抜き性としてF. A. R（%）、バリ（μm）の各種特性評価を行った。評価方法は実施例1と同様である。

【表7】

	No	再結晶処理 ℃×s	冷間加工 加工率%	時効条件 ℃×hr	最終加工 加工率%	最終焼鈍 ℃×hr	
本 発 明 例	45	750×30	処理無し	515×2	0	処理無し	No. 2と同じ
	46	725×30	↑	↑	↑	↑	No. 18と同じ
	47	800×30	↑	↑	↑	↑	No. 19と同じ
	48	850×30	↑	↑	↑	↑	No. 20と同じ
	49	900×30	↑	↑	↑	↑	No. 21と同じ
	50	750×30	↑	535×2	↑	↑	
	51	↑	20	500×2	↑	↑	
	52	↑	処理無し	515×2	10	375×2	
	53	↑	↑	↑	20	350×2	
比 較 例	54	680×30	処理無し	515×2	0	処理無し	No. 34と同じ
	55	930×30	↑	↑	↑	↑	No. 35と同じ
	56	750×30	↑	400×2	↑	↑	
	57	750×30	↑	560×2	↑	↑	
	58	750×30	↑	515×2	33	350×2	
	59	750×30	↑	515×2	20	処理無し	

【表8】

	No	TS N/mm ²	EI %	EC % IACS	曲げ 加工性	S. R. R %	Snメッキ 剥離性	打ち抜き性	
								F. A. R (%)	バリ (μm)
本 発 明 例	45	670	16	39	B	18	剥離無し	45	6
	46	680	14	39	C	20	↑	46	6
	47	670	16	39	B	18	↑	44	7
	48	670	16	39	B	18	↑	41	9
	49	660	13	39	C	19	↑	39	11
	50	640	17	40	B	21	↑	46	7
	51	680	12	40	B	17	↑	49	5
	52	670	13	39	B	17	↑	47	7
	53	680	12	40	B	16	↑	50	5
比 較 例	54	680	12	39	D	22	剥離無し	45	8
	55	650	9	39	D	25	↑	40	12
	56	550	19	35	B	29	↑	31	14
	57	540	18	42	A	30	↑	34	11
	58	730	8	40	D	16	↑	53	3
	59	730	4	38	D	22	↑	61	2

【0051】表7、表8から明らかなように、本発明例の工程で製造した合金である本発明例No. 45～No. 53はどれも優れた特性を示した。しかしながら、

55は930℃×30sで熱処理を行ったために、結晶粒はおよそ30μmとなった。粗大な結晶粒であるため、曲げ加工性に悪影響を及ぼすばかりでなく、若干応

が不十分なため強度特性が劣化した。同時に応力緩和特性も大幅に低下した。逆にNo. 57は時効温度が高く、析出物が粗大化したため、応力緩和特性が大幅に低下した。比較例No. 58は時効後に本発明で規定する以上の加工率で冷間加工を行った例である。応力緩和特性はむしろ優れるが、曲げ加工性が低下した。比較例No. 59は時効後の冷間加工率は高くないが、その後熱処理を行わなかった例である。伸びが低く曲げ加工性が低下したばかりでなく、応力緩和特性も若干低下した。

【0053】

【発明の効果】以上記述したように、本発明の銅合金は、Cuマトリックス中にNiとSiの化合物を析出させ、Sn、Mg、或いは更にZnを特定量添加し、S、O含有量を制限して、かつ結晶粒度を $1\mu\text{m}$ を越え $25\mu\text{m}$ 以下としたことにより、優れた機械的特性、伝導性、応力緩和特性と曲げ加工性を兼ね備えた銅合金が得

られるという効果を奏するものである。特に、端子・コネクター用として、強度や伝導性、応力緩和特性、曲げ成形性に優れ、またSnメッキの耐加熱剥離性や打ち抜き性にも優れるものであるから、近年の傾向である小型、高性能化に好適に対応できる。また本発明は端子・コネクター用途に好適なものであるが、その他スイッチ、リレー材等、一般導電材料としても好適な銅合金を提供するという効果を奏するものである。

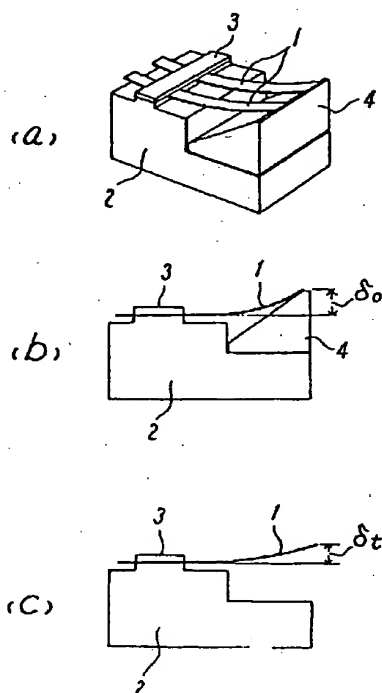
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明実施例の応力緩和の試験を説明する図

【符号の説明】

- 1 サンプル
- 2 基台
- 3 保持部材
- 4 ブロック

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶

C22F 1/00

識別記号

661

685

686

FI

C22F 1/00

661A

685Z

686A

694

694A

(72)発明者 大山 好正
東京都千代田区丸の内2丁目6番1号古河
電気工業株式 会社内